

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(10) 国際公開番号

WO 2011/004657 A1

PCT

(43) 国際公開日
2011 年 1 月 13 日(13.01.2011)

- (51) 国際特許分類:
H01L 21/301 (2006.01) C09J 7/02 (2006.01)
C09J 5/00 (2006.01) C09J 201/00 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2010/059188
- (22) 国際出願日: 2010 年 5 月 31 日(31.05.2010)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2009-163034 2009 年 7 月 9 日(09.07.2009) JP
- (71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 住友ベークライト株式会社(SUMITOMO BAKE-LITE COMPANY LIMITED) [JP/JP]; 〒1400002 東京都品川区東品川 2 丁目 5 番 8 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 安田 浩幸 (YASUDA Hiroyuki) [JP/JP]; 〒1400002 東京都品川区東品川 2 丁目 5 番 8 号 住友ベークライト株式会社内 Tokyo (JP). 平野 孝 (HIRANO Takashi) [JP/JP]; 〒1400002 東京都品川区東品川 2 丁目 5 番 8 号 住友ベークライト株式会社内 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: 朝比 一夫, 外(ASAHI Kazuo et al.); 〒1050003 東京都港区西新橋 1 丁目 1 8 番 9 号 西新橋ノアビル 4 階 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア

[続葉有]

(54) Title: FILM FOR SEMICONDUCTOR AND SEMICONDUCTOR DEVICE MANUFACTURING METHOD

(54) 発明の名称: 半導体用フィルムおよび半導体装置の製造方法

[図4]

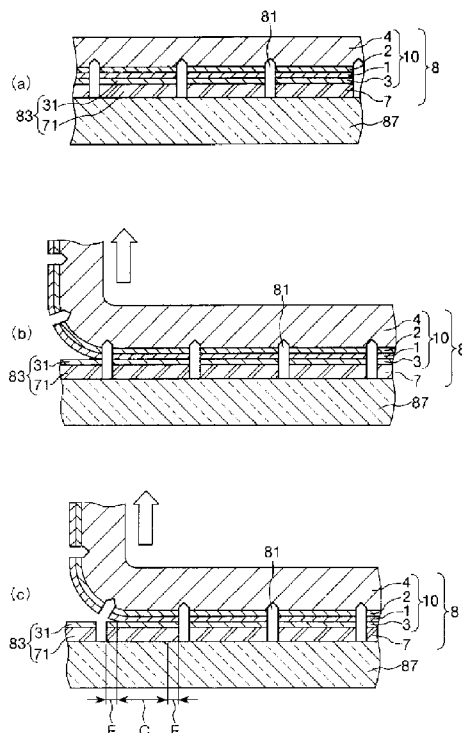


FIG. 4

(57) Abstract: A film for a semiconductor comprises a support film, a second adhesive layer, a first adhesive layer, and a bonding layer stacked in this order. The film for a semiconductor allows a semiconductor wafer to be stacked on the bonding layer, supports the semiconductor wafer when the semiconductor wafer is diced, and is structured so as to be selectively peeled off at the interface between the first adhesive layer and the bonding layer when the cut and separated semiconductor wafer (semiconductor device) is picked up. The film for a semiconductor is stacked with a semiconductor wafer, which is cut and separated by dicing, and then the adhesive forces of the obtained semiconductor device are measured. The film for a semiconductor is characterized in that when the adhesive force at the edge portion of a semiconductor device is denoted by a (N/cm) and the adhesive force at the central portion (portion other than the edge portion) of the semiconductor device is denoted by b (N/cm), the ratio a/b is 1 to 4 inclusive. Since the ratio a/b is optimized, when picking up a semiconductor device, it is possible to reliably prevent problems such as cracks, breaks, etc., of the semiconductor device caused by a high load locally applied to the semiconductor device.

(57) 要約:

[続葉有]

WO 2011/004657 A1